

نانوالکترونیک با میکروسکپ - نیروی اتمی

با میکروسکپ - نیروی اتمی کانال‌های رسانا درون - یک توده ی نارسانا ساخته اند. این کانال‌ها با اعمال - ولتاژ در جاها ی معین ساخته می‌شوند، و با اعمال - ولتاژ - معکوس یا با تاباندن - نور می‌شود آنها را پاک کرد. با این روش توانسته اند در مرز - لانتانم آلومینات و سترنسیم تیتانات (هر دو نارسانا) ترانزیسترها ی اثرمیدان ی به کوچکی ی تا 2 nm بسازند [1]. اندازه ی کوچک‌ترین ساختارها یی که با روش‌ها ی فعلی ی لیتوگرافی ی اپتیک ی در سیلیسیم می‌سازند 20 nm است.